

Judul:

Simulasi kurva C-V akibat efek deplesi gate polisilikon akibat pengaruh dopant profile dan geometri gate dalam scaled MOS

Pengarang/Penulis:

Daniel D S, author

Subjek:

Engineering mathematics.

Nomor Panggil:

S39983

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)